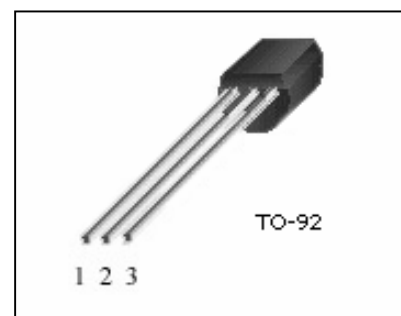


КП502А

Н-КАНАЛЬНЫЙ МОП ТРАНЗИСТОР

АДБК 432140.658 ТУ

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ И N-КАНАЛОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЛЕФОНИИ, ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ, В РЕГУЛЯТОРАХ, СТАБИЛИЗАТОРАХ С НЕПРЕРЫВНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, БЛОКАХ ПИТАНИЯ ЭВМ, СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ДРУГОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ.



1 - Исток 2 - Сток 3 - Затвор

- * Зарубежный аналог - **BSS124**
- * Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**.

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм	Значение
Напряжение сток-исток	Уси max	В	400
Напряжение затвор-исток	Узи max	В	±10
Постоянный ток стока	Iс max	А	0.12
Импульсный ток стока	Iс и max	А	0.48
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	1.0
Температура перехода	Tпер	°С	150

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измерения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Узи пор	В	Iс=1.0мА, Узи=Уси	1.5	2.5
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	Rси отк	Ом	Iс=120мА, Узи=10В ti<300мкс. Q >50		28
Остаточный ток стока	Iс ост	мкА	Уси=400В, Узи=0		1.0
Ток утечки затвора	Iз ут	нА	Уси=0, Узи= ±20В ti<300мкс. Q >50		± 100
Крутизна ВАХ	S	А/В	Уси ≥7В, Iс=120мА ti<300мкс. Q >50	0.1	
Прямое напряжение на диоде	* Упр	В	Узи=0, Iс=240мА ti<300мкс. Q >50		1.3
Время включения	* tвкл	нс	Узи=10В, Iс= 210мА Уси=30В, Rзи=50 Ом ti<300мкс. Q >50		35
Время выключения	* tвыкл	нс	Узи=10В, Iс= 210мА Уси=30В, Rзи=50 Ом ti<300мкс. Q >50		70
Входная емкость	* C11и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц		100
Выходная емкость	* C22и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц		15
Проходная емкость	* C12и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц		11

* Справочные параметры

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>